

وابستگی اندازه نانوذرات YSZ در نشست الکتروفورتیکی به روش ایجاد هدایت الکتریکی سطحی کامپوزیت NiO-YSZ جهت کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد

طاهره طالبی *، امیر مقصودی پور، بابک رئیسی و محسن حاجی

پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک

تاريخ ثبت اوليه: ١٣٨٨/٠٥/١٥، تاريخ دريافت نسخه اصلاح شده: ١٣٨٨/٠٢/١٨، تاريخ پذيرش قطعي: ١٣٨٨/٠٨/١٢

چکیدہ

در این پژوهش، از ۳ روش مختلف جهت هادیسازی آند استفاده شد. روش اول، پوشش دهی گرافیت بر سطح زیرلایههای NiO-YSZ استفاده از روش رنگآمیزی بود. در روش دوم، کامپوزیت NiO-YSZ در دمای C^{*} ۸۵۰ در اتمسفر هیدروژن/آرگون احیا و سرمت Ni-YSZ ساخته شد. در روش سوم، عملیات خاصی جهت هادیسازی انجام نگرفت، ولی این روش تنها در مورد زیرلایههای دارای تحلخل باز بیشتر از ۵۰ درصد قابل استفاده بود. سوسپانسیون یکنواخت و پایداری از SZY در محیط آلی مخلوط استن و اتانول خالص جهت الفال باز بیشتر از ۵۰ در محیط آلی مخلوط استن و اتانول خالص تخلخل باز بیشتر از ۵۰ درصد قابل استفاده بود. سوسپانسیون یکنواخت و پایداری از SZY در محیط آلی مخلوط استن و اتانول خالص جهت انجام فرفت. ولی این روش تنها در مورد زیرلایههای دارای مخلخل باز بیشتر از ۵۰ درصد قابل استفاده بود. سوسپانسیون یکنواخت و پایداری از SZY در محیط آلی مخلوط استن و اتانول خالص جهت انجام فرآیند الکتروفورتیک، ساخته شد. سپس سینتر در دمای بالا انجام گرفت. در ادامه، جریان عبوری از مدار، وزن نشست و دانسیته فیلم اندازه گیری شد. نهایتا ریزساختار سطح پوشش و ضخامت آن در حالت خام و سینتر شده توسط SEA بررسی گردید. نتایج بهت اندانه دوزن نشست و اتانول غالص دانسیته فیلم اندازه گیری شد. نهایتا ریزساختار سطح پوشش و ضخامت آن در حالت خام و سینتر شده توسط SEA بررسی گردید. نتایج نشان دادند که وزن نشست دانسیته فیلم و جریان عبوری از مدار با افزایش مقاومت کاهش پیدا میکند. همچنین مشاهده شد که با کاهش هدایت الکتریکی، اندازه ذرات نشست یافته به زیر ۱۰۰۰ نانومتر کاهش مییابد. کوچکترین اندازه ذره در هنگام استفاده از زیرلایه اشباع شده حاصل گردید که برابر ۵۹ ۵۹ اندازه گیری شد. کیفیت لایه نشست یافته نیز با افزایش هدایت الکتریکی زیرلایه بهبود مییابد.

واژههای کلیدی: نانو ذرات YSZ، هدایت الکتریکی آند، نشست الکتروفورتیکی، پیل سوختی اکسید جامد.

۱– مقدمه

پیلهای سوختی ابزارهایی هستند که میتوانند انرژی

talebytahereh@yahoo.com تلفن: ٩-٢٠٢٥، دورنگار: ۶۲۰۱۸۸۸ ۲۶۱-۶۲۰، پستالکترونیکی: sipytahereh@yahoo.com تلفن: ٩-

شیمیایی حاصل از سوخت گازی را از طریق واکنش الکتروشیمیایی بین سوخت و اکسیدکننده به صورت مستقیم به انرژی الکتریکی و حرارتی تبدیل کنند. امروزه

^{*} **عهدەدار مكاتبات**: طاهرە طالبى

نشانی: تهران، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک

پیلهای سوختی اکسید جامد (SOFCs) به عنوان روشهای جدید تولید برق، به دلیل راندمان تبدیل انرژی

بالا و عمر طولانی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند [۱]. در این میان، پیلهای سوختی اکسید جامد به علت استفاده از حاملهای ^{-C}O در الکترولیت و نیز دمای کار کرد بالا، دارای مزایای ویژهای نسبت به سایر پیلهای سوختی هستند. این مزایا عبارتند از: استفاده از سوختهای غیرهیدروژنی (و استفاده از جزء کربنی سوخت)، بازده بالاتر، استفاده از حرارت تولید شده، جامد بودن الکترولیت، عدم استفاده از مواد گران قیمت و عدم پلاریزاسیون [۲].

مهمترين ماده جهت ساخت الكتروليت نيز YSZ مىباشد، چرا که دارای خواص منحصربفردی در زمینههایی چون پایداری در زمانهای طولانی، استحکام مکانیکی و دوام است [۵-۳]. جهت کاهش دمای کارکرد پیلهای سوختی اکسید جامد میبایست الکترولیتهایی نازک و چگال از YSZ تولید نمود [۶،۷]. بنابراین، روشهای گران تهیه لایههای نازک مانند: نشست بخار شیمیایی و فیزیکی (CVD ،PVD) [۸،۹] و برخی از روشهای کلوئیدی مانند: پوششدهی دوغابی و نشست الکتروفورتیک (EPD یا Electrophoretic Deposition) که مقرون به صرفهتر هستند، مورد بررسی قرار گرفتهاند [۱۰،۱۱]. فرآيند پوششدهى الكتروفورتيكى جهت تهيه پوششهاى سرامیکی استفاده گردیده است [۸–۶]. در سالهای اخیر، استفاده از این روش جهت ساخت الکترولیت نازک بر سطح آند و کاتد پیل سوختی اکسید جامد مورد توجه ویژهای قرار گرفته است [۱۱]؛ زیرا می توان از آن جهت شکلدهی فیلمهای یکنواخت نازک بر روی زیرلایههایی با اشکال پیچیده مانند استک لولهای پیلهای سوختی (Tubular Cell Stack) بهره گرفت [۱۲]. این روش دارای سرعت نشست بالا و ريزساختار يكنواخت با ضخامت لايه یکسان در تمام سطح نشست میباشد [۱۳]. با این حال نیاز به تجهیزات پیچیده و گران قیمت ندارد. این مزایا روش EPD را جهت ساخت الكتروليت پيلهاى سوختى فرآیندی مناسب میسازد [۱۴]. عوامل موثر بر فرآیند نشست الكتروفورتيك بسيار هستند. اما در اين پژوهش، تنها عامل متغیر، هدایت الکتریکی زیرلایه در نظر گرفته

شد که مطالعات کمی بر آن انجام گرفته است. پس از اندازه گیری دقیق وزن نشست و جریان عبوری از مدار و محاسبه دانسیته خام، ریزساختار پوشش حاصله، مورفولوژی سطح نمونه ها و ضخامت فیلم نشست یافته، در حالت خام و سینتر شده توسط SEM بررسی شد. اندازه ذرات تشکیل دهنده فیلم نشست یافته حدود ۵۹ نانومتر اندازه گیری شد. مشاهده شد که مقاومت سطحی ویژه کمتر، باعث کیفیت بهتر نشست و سطح یکنواخت تر در هر دو حالت خام و سینتر شده می گردد.

۲- فعالیتهای تجربی

ابتدا پودرهای YSZ (۲۰۵۰-۲۵ mol Y₂O₃-ZrO₂) YSZ ژاپن)، NiO (Merck) MiO و نشاسته به ترتیب با نسبت وزنی ۵:۵:۲، به مدت ۲۴ ساعت جهت آمادهسازی کامپوزیت پیل سوختی بالمیل شدند. پس از خشک کردن مخلوط در ℃ ۷۰ به مدت ۲۴ ساعت، پودر حاصل به مورت قرصهایی با قطر ۱۵ میلیمتر و ضخامت ۷/۰ میلیمتر توسط پرس تکمحوره هیدرولیک با فشار Norbar

در مرحله بعد، زیرلایهها در دمای C° ۱۰۰۰ به مدت ۳ ساعت پخت شدند تا کامپوزیت متخلخلی از NiO-YSZ به عنوان زیرلایه فرآیند EPD حاصل گردد. پس از انجام فرآیند پخت و خروج مواد آلی، قرصها دارای استحکام کافی جهت انجام فرآیند نشست الکتروفورتیکی بودند. برای اندازه گیری مقدار تخلخل باز آندهای ساخته شده، از روش ارشمیدسی استفاده گردید.

زیرلایههای فرآیند نشست الکتروفورتیکی باید دارای هدایت الکتریکی باشند تا لایه نشست بر سطح آنها تشکیل گردد. بنابراین میبایست سطح آندها را هادی نمود. در این مقاله، از ۳ روش مختلف جهت هادیسازی آند استفاده شد. روش اول پوشش دهی گرافیت بر سطح زیرلایههای NiO-YSZ با استفاده از روش رنگآمیزی (painting) بود. در روش دوم، کامپوزیت NiO-YSZ در دمای C ۵۰ ۸ در اتمسفر هیدروژن/آرگون با نسبت ۹۳:۲ به مدت ۵ ساعت با سرعت گرمایش و سرمایش به مدت ۵ اعت با سرعت گرمایش و سرمایش



سوم، عمليات خاصي جهت هاديسازي انجام نگرفت، ولي این روش، تنها در مورد زیرلایههای دارای تخلخل باز بیشتر از ۵۰ درصد قابل استفاده بود. در این روش اشباع زيرلايه متخلخل از سوسپانسيون مورد آزمايش باعث ايجاد هدایت الکتریکی کمی می گردد و انجام نشست الکتروفورتیک را ممکن میسازد. پس از هادیسازی آندها توسط ۳ روش مذکور، مقاومت الکتریکی ویژه سطحی زیرلایه توسط دستگاه USA ،Four Point Probe، مدل FPP5000 اندازه گیری شد. جهت انجام فرآیند الکتروفور تیک، سوسپانسیون یکنواخت و پایداری از YSZ توسط حمام اولتراسونیک به مدت ۱۵ دقیقه در محیط آلى مخلوط استن و اتانول خالص (Merck، #Ivv و ۱۰۰۹۸۳، بهترتیب) با نسبت حجمی ۲۵:۷۵ ساخته شد. سوسپانسيون تهيه شده قبل از فرأيند EPD دوباره به مدت ۵ دقیقه در حمام اولتراسونیک قرار گرفت. پودر YSZ در سوسپانسیون استن- اتانول دارای پتانسیل زتا برابر ۲/۰۵ eV بود، که توسط دستگاه میکروالکتروفورتیک Malvern -Zetasizer 3000Hz اندازه گیری شد. فاصله بين كامپوزيت NiO-YSZ به عنوان الكترود منفى و صفحه فولادی ضد زنگ بهعنوان الکترود مثبت در فرآیند EPD، ثابت و برابر ۱۰ میلیمتر در نظر گرفته شد. دو الکترود در طول فرآیند EPD به صورت عمود، موازی و ثابت نگه داشته شدند. جهت جلوگیری از تبخیر سوسپانسیون از درپوش استفاده گردید. فیلم چگال و نازک YSZ در ولتاژهای متفاوت و زمانهای متفاوت نشست داده شد. در شکل ۱ نمای شماتیک دستگاه نشست الکتروفورتیک



نشان داده شده است.

شکل ۱: نمای شماتیک دستگاه نشست الکتروفور تیک مورد استفاده هادیسازی با a) پوشش گرافیت و b) زیرلایه احیا یا اشباع شده.

در هنگام انجام فرآیند EPD، جریان عبوری از مدار با استفاده از میکروآمپرسنج مدل Fluke187 برحسب زمان اندازه گیری و ثبت گردید. در نهایت پس از تهیه پوشش مناسب و یکنواخت بر سطح کامپوزیتهای NiO-YSZ توسط روشهای مختلف، سینتر نهایی در دمای ۱۴۰۰ °C

با اندازه گیری دقیق جرم کامپوزیتها قبل و بعد از فرآیند EPD، و نیز اندازه گیری مساحت نشست یافته بر سطح کامپوزیت، وزن نشست بر حسب مساحت محاسبه شد و جهت رسم نمودار مربوطه مورد استفاده قرار گرفت.

ریزساختار پوشش حاصل و مورفولوژی سطح نمونهها در حالت خام و سینتر شده و نیز ضخامت فیلم خام، توسط SEM (میکروســـکوپ الکترونـــی روبشــی، مــدل Streoscan360) بررسی شد.

پس از آن، محاسبه دانسیته خام لایههای نشست یافته در حالت پوششدهی با گرافیت و اشباع شده انجام گرفت. علاوه بر آن، از مشاهدات میکروسکوپ نوری جهت تعیین کیفیت لایه سینتر شده استفاده گردید.

۳- نتایج و بحث ۳-۱- بررسی وزن نشست بر سطح کامپوزیت

در این مقاله تنها عامل متغیر، هدایت الکتریکی زیرلایه در نظر گرفته شد و از ۳ نوع زیرلایه که دارای مقدار مقاومت ویژه سطحی متفاوت بودند، استفاده شد. مقاومت ویژه سطحی زیرلایه روش پوشش دهی با گرافیت (۵۳۳ Ω ۳۳) کمتر از سایرین و نزدیک مقاومت ویژه سطحی زیرلایه احیا شده (۵۳ 0 0 است. همچنین مقاومت ویژه سطحی زیرلایه روش اشباع شده یا دارای تخلخل فراوان دارای تفاوت بسیاری بوده (۵۲ Ω 0) و به شدت بالاتر است تفاوت بسیاری بوده (۵۲ Ω مقاومت ویژه فولاد ضد زنگ برابر ربرای مقایسه، مقاومت سطحی ویژه فولاد ضد زنگ برابر سوم، (برای مقایسه، مقاومت سطحی ویژه فولاد ضد زنگ برابر انجام نشست الکتروفورتیک امکان پذیر و هدایت نسبی در زیرلایه حاصل می گردد.

شکل ۲ آنالیز XRD از دو نمونه قبل و بعد از احیا در محیط ۷ درصد هیدروژن ۹۳ درصد آرگون در دمای C° ۸۵۰، را نشان میدهد. همان طور که مشاهده می گردد، تنها تغییر

R

140

149

انجام گرفته، واکنش تبدیل و احیا اکسید نیکل به نیکل فلزی به صورت کامل بوده و تغییر فازی دیگری مشاهده نشد.



شكل ۲: نتايج آناليز XRD از دو نمونه a) بعد از احيا و b) قبل از احيا.

در شکل ۳، رابطه وزن نشست - ولتاژ برای سه روش هادیسازی در زمان ثابت ۲ دقیقه با استفاده از سوسپانسیون استن- اتانول نشان داده است. همانطور که مشاهده میشود، مقدار وزن نشست با استفاده از روش احیا و پوششدهی با گرافیت تقریبا نزدیک بههم میباشد. با این حال، به علت هدایت الکتریکی بیشتر در روش پوششدهی با گرافیت، وزن نشست آن کمی بالاتر است. درصورتی که از روش اشباع زیر لایه و تخلخل فراوان جهت EPD استفاده شود، وزن نشست بسیار کمتر خواهد بود. نشست الكتروفورتيك عموما بر زيرلايههايي با هدايت الكتريكي امكان پذير است. با اين حال مشاهده شد بر سطح زيرلايه با مقاومت سطحى بسيار بالا نيز نشست انجام گرفت. جهت توجیه این پدیده، در مقاله ماتسودا پیشنهاد شده است که به علت تخلخل بسیار زیاد این زیرلایههای اشباع شده، در درون آنها مسیر هدایت الكتريكي ايجاد شده و باعث به وجود آمدن هدايت الکتریکی نسبی در سطح زیرلایه می شود و در نتیجه انجام نشست ممکن می گردد [۵].

نتایج حاصل از آزمایشهای EPD روند معکوسی را بین مقاومت سطحی ویژه و وزن نشست یافته نشان میدهد. بدین معنی که، کاهش مقدار مقاومت ویژه سطحی منجر به افزایش وزن نشست یافته می گردد. به نظر میرسد، با

افزایش هدایت الکتریکی زیرلایه و کاهش مقاومت ویژه آن، فرآیند EPD به طور موثرتری بر سطح آند زیرلایه صورت می پذیرد. این امر می تواند به علت توزیع یکنواخت ر و قوی تر میدان الکتریکی در سوسپانسیون باشد که باعث حرکت بهتر ذرات می گردد [۳].



شکل ۳: رابطه وزن نشست و ولتاژ در سه روش متفاوت هادیسازی در زمان ۲ دقیقه.

۲-۳ بررسی جریان عبوری از مدار فرآیند لایه
نشانی الکتروفورزیس

در شکل ۴ نمودار جریان – زمان سه روش هادی کردن زیرلایه در ولتاژ ثابت ۷ ۲۰ برای سوسپانسیون استن-اتانول آورده شده است. همانطور که مشاهده می گردد، روش ایجاد هدایت با پوشش گرافیت دارای بالاترین جریان عبوری از مدار و روش هادیشده توسط اشباع از سوسپانسیون و میزان بالای تخلخلها دارای کمترین جریان عبوری از مدار است.



شکل ۴: نمودار جریان – زمان سه روش هادی کردن زیرلایه در ولتاژ ثابت V ۲۰.



همان طور که ذکر شد، مقاومت ویژه سطحی زیرلایه پوشش یافته از گرافیت برابر ۵۳۳ ، زیرلایه احیا شده برابر ۵۴۵۰ ۵ و زیرلایه اشباع شده نیز ۵۴۵۰ ۵ است. همچنین، بر طبق قانون اهم هر چه مقاومت اجزاء تشکیل دهنده مدار کمتر باشد، جریان عبوری از مدار بالاتر خواهد رفت [۱۲]. بنابراین، هنگامی که زیرلایه پوشش یافته گرافیتی استفاده میشود، به دلیل اینکه این زیرلایه نسبت به دو روش دیگر دارای مقاومت پایین تری است، جریان عبوری از مدار افزایش می یابد.

از نتایج تغییرات جریان عبوری از مدار فرآیند لایهنشانی الکتروفورزیس در بررسیهای ریزساختاری فیلم نشست یافته استفاده گردید.

۳-۳- بررسی ریزساختاری سطح فیلمهای نشست یافته خام توسط SEM

در شکل ۵۵-۵، تصاویر SEM از سطح سه نمونه که با روشهای مختلف هادی شدهاند، در زمان ۲ دقیقه و ولتاژ ۲۰۷ مشاهده میشود. همانطور که دیده میشود، تفاوت مشخصی بین اندازه دانه در سطح نمونههای زیرلایه با گرافیت پوشش داده شده و زیرلایه اشباع شده و نیز زیرلایه احیا شده وجود دارد.

همچنین شکل ۵ نشان میدهد، ذراتی که بر سطح زیرلایه پوشش داده شده با گرافیت نشست یافتهاند، بزرگتر از دو روش دیگر هستند. اما بهنظر میرسد که آنها از ذرات کوچکتری شکل یافته و در حقیقت به صورت الگومرههای کوچک بر سطح کامپوزیت NiO-YSZ نشست پیدا کردهاند، درحالی که دانههای موجود بر سطح زیرلایه اشباع شده به صورت پراکنده بوده و دارای اندازه بسیار کوچکتری در حدود ۹۳ م

این تفاوت اندازه ذرات، احتمالا به دلیل تفاوت هدایت الکتریکی زیرلایهها مشاهده می گردد. به علت هدایت الکتریکی تقریبا مشابه زیرلایههای احیا شده و پوشش داده شده با گرافیت، تفاوت کمتری بین دو دسته از نمونهها دیده می شود. اما هنگامی که از زیرلایه اشباع شده استفاده می گردد که دارای اختلاف بسیار شدیدتری با دو نمونه قبلی است، این تفاوت اندازه دانه خود را به خوبی نشان می دهد. مشاهده می شود که اندازه دانههای ذرات در

حالت اشباع شده از سایر روشها کوچکتر بوده و حدود ۵۹ نانومتر بوده است.

در ادامه دو روش زیرلایه با پوشش گرافیتی و اشباع شده که دارای تفاوت بیشتری بودند، مورد بررسیهای بیشتر قرار گرفتهاند.





(**b**)

شکل ۵: تصاویر SEM با بزرگنمایی بالا از سطح پوشش در زمان ۲ دقیقه و ولتاژ ۲ ۲۰، a) پوششدهی با گرافیت، b) زیرلایه احیاشده و c) زیرلایه اشباع شده.

 (\mathbf{c})

۴-۳ بررسی ولتاژ با دانسیته لایه خام نشست
یافته

رابطه دانسیته فیلم نشست یافته بر حسب ولتاژ در شکل ۶ نشان داده شده است. با بررسی دانسیته خام در دو حالت با تفاوت بیشتر مقاومت الکتریکی، مشاهده گردید فیلم نشست یافته بر پوشش گرافیتی دارای دانسیته خام بسیار بالاتری بود.

دلیل این مساله میتواند جریان بالاتر ذرات در مدار فرآیند لایهنشانی الکتروفورزیس باشد [۸،۹]. در نتیجه، ذرات پراکنده شده در سوسپانسیون در هنگام حرکت به سمت زیرلایه با هدایت الکتریکی بیشتر، دارای سرعت بالاتری بوده و نشست متراکمتری تشکیل میدهد. بنابراین دانسیته فیلم در حالت استفاده از زیرلایه پوشش داده شده با گرافیت، بیشتر از زیرلایه اشباع شده است.





دانسیته فیلمهای خام بر کیفیت این فیلمها به خصوص پس از سینتر بسیار موثر بود؛ که در بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد.

۳–۵– بررسی کیفیت فیلم YSZ سینتر شده توسط میکروسکوپ نوری

شکل ۷a,b تصاویر سطح سینتر شده از فیلمهای YSZ بر زیرلایههای پوشش داده شده با گرافیت و اشباع شده را نشان میدهد که در ولتاژ ۲۰۷ و زمان ۶ دقیقه پوشش داده شده است. زمان طولانیتر نشست الکتروفورتیک به علت مشاهده آسانتر تفاوت دو روش توسط میکروسکوپ نوری، مورد استفاده قرار گرفته است.



شکل ۷: تصاویر میکروسکوپ نوری از سطح فیلم YSZ سینتر شده در دمای C⁰ ۱۴۰۰ به مدت ۲ ساعت، a) پوشش داده شده با گرافیت و b) اشباع شده.

این نمونهها در دمای C^o ۱۴۰۰ برای ۲ ساعت سینتر شده بودند. ترکهای فراوانی بر سطح فیلم YSZ زیرلایه اشباع شده مشاهده می گردد. در حالی که بر سطح فیلم YSZ زیرلایه پوشش داده شده با گرافیت هیچ ترکی مشاهده نشده و فیلم سفید و یک دستی مشاهده می گردد. استفاده از زمان کم سینتر به دلیل به دست آوردن تصاویر واضحتر و مشاهده دقیق تر بود. زیرا با بالا بردن زمان و شفاف شدن فیلم، مشاهده تمایز بین این دو زیرلایه سخت تر می شد. همچنین زمان بیشتر می توانست تا حدی ترکهای سطحی را از بین برده و در مشاهدات، تداخل دو اثر را ایجاد کند. این تصاویر نشان می دهد کیفیت فیلم بر سطح زیرلایه پوشش داده شده با گرافیت، بهتر از زیرلایه اشباع شده بود.







نکل ۸: تصاویر SEM سطح فیلم YSZ سینترشده بر زیرلایه، (a,b) اشباع شده در بزرگنماییهای متفاوت و c) پوشش داده شده با گرافیت (مقیاسها برابر نیستند).

۴- نتیجهگیری

در این پژوهش، از ۳ روش مختلف جهت هادی سازی آند استفاده شد. روش اول پوشش دهی گرافیت بر سطح زیرلایه های ViO-YSZ با استفاده از روش painting بود. در روش دوم، کامپوزیت NiO-YSZ در دمای C° ۸۵۰ در اتمسفر هیدروژن/آرگون احیا و سرمت Ni-YSZ ساخته شد. در روش سوم، عملیات خاصی جهت هادی سازی انجام نگرفت، ولی این روش تنها در مورد زیرلایه هایی که دارای تخلخل باز بیشتر از ۵۰ درصد بودند، قابل استفاده بود. جهت انجام فرآیند الکتروفورتیک، سوسپانسیون یکنواخت و پایداری از SZ در محیط آلی مخلوط استن و اتانول خالص ساخته شد. جریان عبوری از مدار و وزن ۳-۶- بررسی کیفیت فیلم YSZ سینتر شده
توسط میکروسکوپ الکترونی

شکل ۸ تصاویر SEM سطح فیلم YSZ سینتر شده در دمای C^o ۱۴۰۰ به مدت ۲ ساعت بر زیرلایه اشباع شده در بزرگنماییهای متفاوت (Aa,b) و زیرلایه پوشش داده شده با گرافیت (Ac) را نشان میدهد. قسمت مشخص شده در شکل Aa در شکل Ab با بزرگنمایی بیشتر نشان داده شده است.

هنگامی که پوشش گرافیت بر سطح زیرلایه اعمال می گردد، پس از سینتر، فیلم XSZ به صورت بسیار یکنواخت تری مشاهده می گردد. تصاویر SEM فیلم YSZ سینتر شده بر زیرلایه اشباع شده حاکی از وجود نانوتر کهایی بر سطح فیلم YSZ است. با این حال، ترکهای مشابهی بر سطح فیلم YSZ سینتر شده دیده نمی شود. این مساله نشان دهنده استحکام کمتر فیلم YSZ سینتر شده در حالت استفاده از زیرلایه اشباع شده است. در این حالت، وجـود نـانوترکهـا حـاکی از وجـود پیونـد ضعیف اولیه در بین ذرات و دانسیته کم فیلم نشست یافته توسط الكتروفورزيس است. وجود اين پيوند ضعيف و دانسیته کم در حالت خام، باعث بهوجود آمدن ترکهای بزرگتر پس از سینتر خواهد شد که در شکل ۷b نیز نشان داده شده بود. با وجود کیفیت متفاوت فیلم پوشش داده شده در هنگام استفاده از دو نوع روش هادیسازی با تفاوت الکتریکی بیشتر، اندازه دانههای YSZ در هر دو حالت تقريبا برابر و حدود ۲ µm است. اين مساله به علت یکسان بودن دمای پخت آنها مشاهده می گردد.



- [2] Z. Xu, G. Rajaram, J. Sankar, D. Pai, *Surface & Coating Technology*, **201**, 2006, 4484.
- [3] S. Kim, O. Kwon, S. Kumar, Y. Xiong, C. Lee, *Surface & Coating Technology*, **202**, 2008, 3180.
- [4] L. Besra, M. Liu, Progess in Materials Science, 52, 2007, 1.
- [5] T. Hosomi, M. Matsuda, M. Miyake, *Journal of the European Ceramic Society*, **27**, 2007, 173.
- [6] S.T. Aruna, K.S. Rajam, *Materials Chemistry and Physics*, **111**, 2008, 131.
- [7] I. Zhitomirsky, A. Petric, *Journal of Materials Science*, **39**, 2004, 825.
- [8] S. Ciou, K. Fung, K. Chiang, *Journal of Power Sources*, 175, 2008, 338.
- **175**, 2008, 338. [9] L. Jia, Z. Lu, X. Huang, *Journal of Alloys and Compounds*, **424**, 2006, 299.
- [10] S. Hayashi, C. Sato, Z. Nakagawa, *Journal of Materials Science*, **41**, 2006, 8068.
- [11] S. Ciou, K. Fung, K. Chiang, *Journal of Power Sources*, **172**, 2007, 385.
- [12] X.J. Lu, X. Wang, P. Xiao, *Thin Solid Films*, **494**, 2006, 223.
- [13] P. Sarkar, D. De, H.R. Ho, *Journal of Materials Science*, **39**, 2004, 819.
- [14] M. Pihlatie, A. Kaiser, M. Mogensen, *Journal of the European Ceramic Society*, **29**, 2009, 1657.

مورفولوژی سطح پوشش خام و سینتر شده توسط SEM بررسی گردید. مشاهده شد با افزایش مقاومت الکتریکی ویژه سطحی، اندازه ذرات نشست یافته به زیر ۱۰۰ نانومتر کاهش یافت.

سپاسگزاری

از اساتید محترم و نیز محققین پژوهشگاه مواد و انرژی جهت راهنماییشان سپاسگزاری مینماییم.

مراجع

[1] L. Besra, C. Compson, M. Liu, *Journal of Power Sources*, **173**, 2007, 130.